

2SC2832, 2SC2832A

シリコン NPN 三重拡散メサ形 / Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

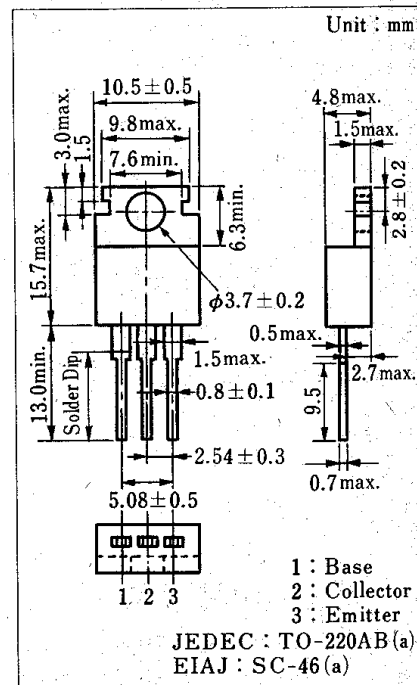
高速スイッチング用 / High Speed Switching

■ 特徴 / Features

- スイッチング速度が速い。 / High speed switching
- コレクタ・ベース電圧 V_{CB0} が高い。 / High V_{CB0}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| Item | Symbol | Value | Unit | |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------------|---|
| コレクタ・ベース電圧 | V_{CB0} | 2SC2832 | 800 | V |
| | | 2SC2832A | 900 | |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V_{CEO} | 500 | V | |
| エミッタ・ベース電圧 | V_{EBO} | 8 | V | |
| せん頭コレクタ電流 | I_{CP} | 10 | A | |
| コレクタ電流 | I_C | 5 | A | |
| ベース電流 | I_B | 3 | A | |
| コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$) | P_C | 40 | W | |
| 接合部温度 | T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ | |
| 保存温度 | T_{stg} | -55 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ | |



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_c=25^\circ\text{C}$)

| Item | Symbol | Condition | min. | typ. | max. | Unit |
|---------------|----------------|---|------|------|------|---------------|
| コレクタ しゃ断電流 | I_{CB0} | $V_{CB}=800\text{ V}, I_E=0$ | | | 100 | μA |
| | | $V_{CB}=900\text{ V}, I_E=0$ | | | 100 | |
| エミッタしゃ断電流 | I_{EBO} | $V_{EB}=5\text{ V}, I_C=0$ | | | 100 | μA |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $V_{CEO(sus)}$ | $I_C=0.2\text{ A}, L=25\text{ mH}$ | 500 | | | V |
| 直流電流増幅率 | h_{FE1} | $V_{CE}=5\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$ | 15 | | | |
| | h_{FE2} | $V_{CE}=5\text{ V}, I_C=3\text{ A}$ | 8 | | | |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$ | | | 1 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$ | | | 1.5 | V |
| トランジション周波数 | f_T | $V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$ | | 3 | | MHz |
| ターンオン時間 | t_{on} | $I_C=3\text{ A}$ | | | 1 | μs |
| | | | | | 1.2 | |
| 蓄積時間 | t_{stg} | $I_{B1}=0.6\text{ A}, I_{B2}=-0.6\text{ A}$ | | | 3 | μs |
| 下降時間 | t_f | $V_{CC}=200\text{ V}$ | | | 1 | μs |
| | | | | | 1.2 | |

This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.